

【発明の名称】

貫通ビア構造体との再配線構造を有する半導体素子 (Semiconductor Device Having TSV and Redistribution Structure)

【要約】

基板の前面上に形成された内部回路、前記基板を垂直に貫通して前記内部回路と電氣的に連結される貫通ビア構造体、前記基板の背面上に形成され、前記貫通ビア構造体と電氣的に連結される再配線構造体、および前記基板の背面と前記再配線構造体の間に形成された背面絶縁層を含み、前記再配線構造体は、再配線バリア層と再配線金属層を含み、前記再配線バリア層には、前記再配線金属層の下面を取り囲みつつ側面を部分的に取り囲む半導体素子が提供される。

【請求項 1】

複数の単位ピクセルを備えるピクセルアレイを含み、被写体の画像情報及び周辺光の情報を含み、ピクセルアレイに照射される光信号に基づいて、ピクセルデータを生成するセンシング部と、前記ピクセルデータに基づいて、前記被写体に相応する画像データ生成部と、前記ピクセルデータに基づいて、前記周辺光に相応する照度データを生成する照度データ生成部と、を含む映像センサー。